

極端紫外	電磁波スペクトルの波長が5ナノメートルを超え、124ナノメートル未満のものをいう。	
多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの	異種の半導体物質が同一結晶方位に結晶構造を連続させて積層成長してできた多層の結晶成長層を有する基板をいう。	
	多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板からなる材料を含む。	
貨物等省令第6条第十八号から第十九号まで、第二十二号から第二十四号まで及び第二十六号中の基板	個別部品又は集積回路を、基板上若しくはその中に配置できるようになっている薄板状のものであって、相互接続の有無によらないものをいう。	
Ⅲ－Ⅴ族化合物	ほう素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム又はこれらの組合せと窒素、 ^{りん} 、砒素、アンチモン、ビスマス又はこれらの組合せとの化合物をいう。	
窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアル	これらの化合物における元素（窒素、ガリウム、インジウム、アルミニウム、 ^{りん} 及び砒素）の順番を問わない。	